

# 推荐！新产品

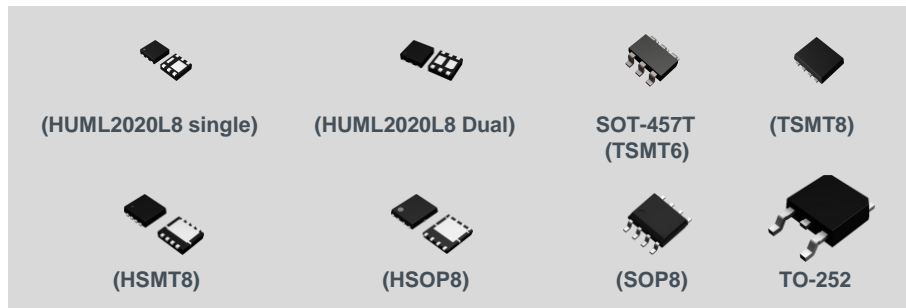


业界先进的超低导通电阻Pch MOSFET登场

## 适用于-40V/-60V工业设备的 Pch MOSFET

第五代 Pch 功率MOSFET单极系列/第五代 Pch 功率MOSFET双极系列

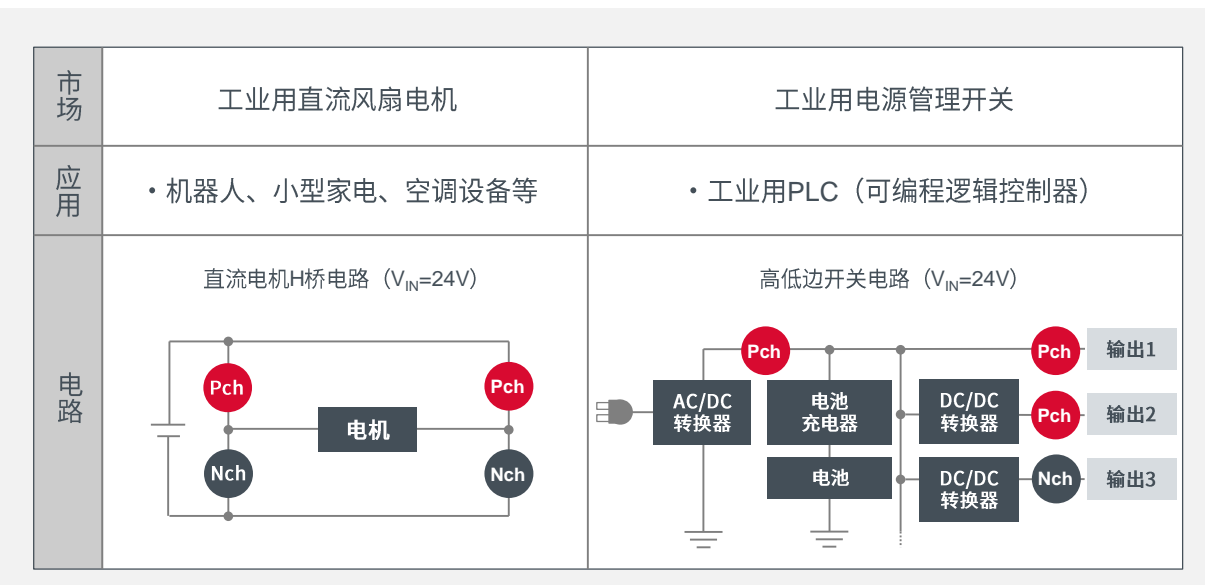
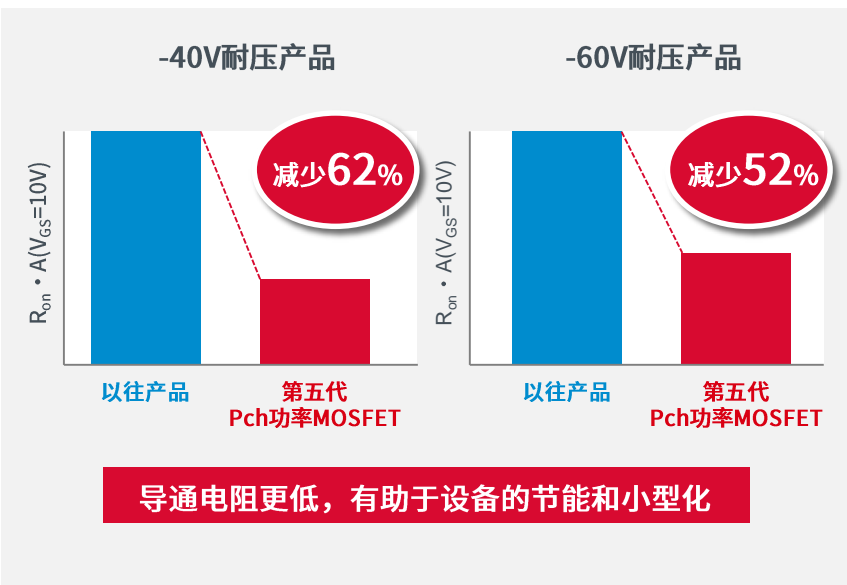
- 业界先进的超低 $R_{on} \cdot A$ （单位面积的 $R_{on}$ ），有助于设备的节能和小型化
- 新设计的微细沟槽结构可避免氧化膜被破坏且提高了质量
- 拥有丰富的封装阵容，其中包括单极18款机型和双极6款机型，有助于减少设计工时并提高可靠性



注：封装采用JEDEC标准。( )内表示ROHM封装。

### 以往产品与新产品的导通电阻比较

### 支持的应用和使用的电路



<单极系列产品阵容>

封装名称	封装尺寸 (mm)	V <sub>DSS</sub> (V)	电流值(A) T <sub>c</sub> =25°C						内部电路图
			0	-5	-10	-15	-35	-55	
<DFN2020-8S> (HUML2020L8 single)	2.0×2.0×0.6	-40	RF4G060AT -6*						
		-60	RF4L040AT -4*						
SOT-457T (TSMT6) [SC-95]	2.8×2.9×0.85	-40	RQ6G050AT -5*						
		-60	RQ6L035AT -3.5*						
(TSMT8)	2.8×3.0×0.8	-40	RQ7G080AT -8*						
		-60	RQ7L050AT -5*						
(HSMT8)	3.3×3.3×0.8	-40	RQ3G110AT -35						
		-60	RQ3L070AT -25						
(HSOP8)	6.0×5.0×1.0	-40	RS1G201AT -78						
		-60	RS1L151AT -56						
(SOP8)	6.0×5.0×1.75	-40	RS3G160AT -16*						
		-60	RS3L110AT -11*						
TO-252 <DPAK>	10.0×6.6×2.3	-40	RD3G01BAT -15						
			RD3G03BAT -35						
			RD3G07BAT -70						
		-60	RD3L01BAT -10						
			RD3L03BAT -35						
			RD3L07BAT -70						

注：封装采用JEDEC标准。( )内表示ROHM封装，[ ]内表示JEITA代码，<>内表示GENERAL代码。

\*Ta=25°C

<双极系列产品阵容>

封装名称	封装尺寸 (mm)	V <sub>DSS</sub> (V)	电流值(A) T <sub>a</sub> =25°C		内部电路图
			0	-5	
<DFN2020-8D> (HUML2020L8 Dual)	2.0×2.0×0.6	-40	UT6JB5 -3.5		
		-60	UT6JC5 -2.5		
(TSMT8)	2.8×3.0×0.8	-40	QH8JB5 -5		
		-60	QH8JC5 -3.5		
(SOP8)	6.0×5.0×1.75	-40	SH8JB5 -8.5		
		-60	SH8JC5 -7.5		

Note: 封装的( )内表示ROHM封装，<>内表示GENERAL代码。



罗姆半导体集团

日本京都市右京区西院沟崎町21号  
邮编：615-8585

www.rohm.com.cn

本资料所记载的内容只是产品的情况介绍。要使用该产品时，请务必通过别的途径获取规格说明书，进一步确认产品的规格及其性能。本资料所记载的内容是力求准确无误而慎重编制的，但万一用户出现因该内容存在错误或打字差错造成损失的情况，罗姆公司不予承担责任。本资料所介绍的技术内容是产品的典型工作状态和应用电路举例等，对于罗姆或其他公司的知识产权及其他所有权利未做明确的、暗示的准予实施或使用的承诺。如因使用这些技术内容而引发纠纷，罗姆公司不予承担责任。在输出本资料所介绍的产品及技术中符合「外国汇兑及外国贸易法」的产品或技术时，或者向国外提供时，必需取得依照该法发放的许可。

本资料中的内容为截至2021年2月1日的信息。

订购罗姆产品